

Низкочастотная релаксационная динамика Na_{1/2}Bi_{1/2}TiO₃

Королева Е.Ю., Вахрушев С.Б.

ФТИ им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург





A- Na или Bi B - Ti Выше 800К - кубическая фаза ~ 800К переход в тетрагональную фазу P4bm Z=2 с нестабильностью в М- точке (1/2, ½, 0) ~620 К появление ромбоэдрической фазы R-3c с нестабильностью в R-точке (1/2, ½, ½) и несоразмерной модуляции в Г-точке вдоль тетрагональной оси 530-670 К область сосуществования двух

фаз

400 К модуляция насыщается с ~6нм периодичностью, но сосуществует с ромбоэдрической фазой вплоть до криогенных температур







Экспериментальное оборудование



Ультраширокополосный диэлектрический спектрометр с криосистемой **Novocontrol BDS80**





Схема электрических измерений

Параметры установки F: 10⁻⁶.. 10⁷ Гц T = 100 ÷ 1300 K Z: 0,01..10¹⁴ Ом; C: 1фФ..1Ф; tg δ: 10⁻⁵..10⁴; относительная погрешность < 3*10⁻⁵

Диэлектрический отклик при нагреве



Диэлектрический отклик при охлаждении



Нагрев и охлаждение



Положение максимума на кривой ε(T) довольно хорошо совпадает с температурой, при которой начинается уменьшение интенсивности сверхструктурных отражений М-типа и возникают отражения R-типа. Можно сделать предположение о том, что максимум диэлектрической проницаемости обусловлен взаимодействием поляризации и параметра порядка Rтипа.

Модельный термодинамический потенциал

$$\begin{split} \mathbf{F} &= \frac{1}{2}A_{P}\sum_{i}P_{i}^{2} + \frac{1}{4}B_{P}\sum_{i}P_{i}^{4} + \frac{1}{2}B_{P}'\sum_{i,j}P_{i}^{2}P_{j}^{2} + \frac{1}{6}D_{P}\sum_{i}P_{i}^{6} + \frac{1}{2}A_{R}\sum_{i}R_{i}^{2} + \frac{1}{4}B_{R}\sum_{i}R_{i}^{4} \\ &+ \frac{1}{2}B_{R}'\sum_{i,j}R_{i}^{2}R_{j}^{2} + \frac{1}{6}D_{R}\sum_{i}R_{i}^{6} + \frac{1}{2}A_{M}\sum_{i}M_{i}^{2} + \frac{1}{4}B_{M}\sum_{i}M_{i}^{4} + \frac{1}{2}B_{M}'\sum_{i,j}M_{i}^{2}M_{j}^{2} + \\ &\frac{1}{2}I_{PM}\sum_{i}P_{i}^{2}M_{i}^{2} + \frac{1}{2}J_{PM}\sum_{i,j}P_{i}^{2}M_{j}^{2} + \frac{1}{2}I_{PR}\sum_{i}P_{i}^{2}R_{i}^{2} + \frac{1}{2}J_{PR}\sum_{i,j}P_{i}^{2}R_{j}^{2} + K_{PR}\sum_{i,j}P_{i}P_{j}R_{i}R_{j} + \\ &\frac{1}{2}I_{RM}\sum_{i}R_{i}^{2}M_{i}^{2} + \frac{1}{2}J_{RM}\sum_{i,j}R_{i}^{2}M_{j}^{2} + \frac{1}{2}C_{11}\sum_{i}\varepsilon_{ii}^{2} + C_{12}\sum_{i,j}\varepsilon_{ii}\varepsilon_{jj} + \frac{1}{2}C_{44}\sum_{i,j}\varepsilon_{ij}^{2} + \\ &+ g_{11}\sum_{i}\varepsilon_{ii}P_{i}^{2} + g_{12}\sum_{i,j}\varepsilon_{ii}P_{j}^{2} + g_{44}\sum_{i,j}\varepsilon_{ij}P_{i}P_{j} + h_{11}\sum_{i}\varepsilon_{ii}M_{i}^{2} + h_{12}\sum_{i,j}\varepsilon_{ii}M_{j}^{2} + \\ &+ f_{11}\sum_{i}\varepsilon_{ii}R_{i}^{2} + f_{12}\sum_{i,j}\varepsilon_{ii}R_{j}^{2} + f_{44}\sum_{i,j}\varepsilon_{ij}R_{i}R_{j} \end{split}$$

Изюмов Ю.А., Сыромятников В.Н. Фазовые переходы и симметрия кристаллов, М. Нука, 1984

Расшифровка структуры NBT

Т>820 К 0'_h - кубическая фаза Ι. $M_i = 0, R_i = 0, P_i = 0$ II. 570К<T<820 К - при нагреве 470К<T<820 К - при охлаждении P4/mbm тетрагональная фаза $M_1 = M_2 = 0, M_3 \neq 0, R_i = 0, P_i = 0$ III. 450К<T<610 К R-3С – ромбоэдрическая неполярная $M_i = 0, P_i = 0, R_i = R \neq 0$ III'. T<450 К R3C – ромбоэдрическая сегнетоэлектрическая $M_{i} = 0, P_{i} = P \neq 0$

Расчетные диэлектрические проницаемости

 $\varepsilon_{ij} \approx \chi_{ij}$ $\chi_{ij}^{-1} = \frac{\partial^2 F}{\partial P_i \partial P_j}$ $A_p = \alpha_p (T - T_p)$ $A_R = \alpha_R (T - T_R)$ Кубическая фаза $\varepsilon_{ij} = \varepsilon \delta_{ij} = \frac{1}{\alpha_P (T - T_p)}$

Тетрагональная фаза

$$\varepsilon_{ZZ} = \frac{1}{\alpha_P(T - T_p) + I_{PM}M^2} \qquad \varepsilon_{XX} = \varepsilon_{YY} = \frac{1}{\alpha_P(T - T_p) + J_{PM}M^2} \quad \varepsilon_T = \frac{1}{3} \left(\varepsilon_{ZZ} + 2\varepsilon_{XX} \right)$$

Ромбоэдрическая неполярная фаза

$$\varepsilon_{\parallel} = \frac{1}{\alpha_P (T - T_p) + R^2 (I_{PR} + 2J_{PR} + 2K_{PR})} \varepsilon_{\perp} = \frac{1}{\alpha_P (T - T_p) + R^2 (I_{PR} + 2J_{PR} - K_{PR})} \varepsilon_R = \frac{1}{3} (\varepsilon_{\parallel} + 2 \varepsilon_{\perp})$$

 $\varepsilon_{\mathcal{A}\Phi} = C_T \varepsilon_T + (1 - C_T \varepsilon_R)$

Оценка температурных зависимостей C_т, R² и M² была сделана на основании данных по рассеянию нейтронов из подгонки температурных зависимостей интенсивностей сверхструктурных отражений.

Из полученных зависимостей вычислялась температурная зависимость диэлектрической проницаемости в двухфазной области.

Экспериментальная и расчетная температурные зависимости диэлектрической проницаемости кристалла NBT



 $I_{PM} = J_{PM}, K_{PR} = 0, I_{PR} = J_{PR}$ $T_c = 490 K$ $1/\alpha_P = 5,44 \cdot 10^5$ $I_{PM} = 25 \cdot \alpha_P$ $I_{PR} = 167 \cdot \alpha_P$

Дисперсионные зависимости



Модельный спектр

$$\mathcal{E}^* = \frac{i\sigma}{\varepsilon_0 \omega} + \sum_i \frac{\Delta \varepsilon_i}{\left(1 + (i\omega\tau_i)^{\alpha_i}\right)} + \varepsilon_{\infty}$$

σ - DC- проводимость

 ε_{∞} - высокочастотная восприимчивость



- Релаксационные вклады, *α* - уширение спектра по сравнению с Дебаевским

Характерные частоты релаксации



Диэлектрические силы процессов



DC - проводимость



выводы:

Максимум температурной зависимости диэлектрической проницаемости NBT при 600К является «несобственным» и может быть объяснен наличием взаимодействия между поляризацией и R-параметром порядка.

Рассчитанная из нейтронных данных температурная зависимость є в двухфазной области достаточно хорошо описывает наблюдаемую экспериментальную зависимость.

Анализ низкочастотных диэлектрических спектров в рамках феноменологических моделей выявил четыре релаксационных процесса. Никаких особенностей вблизи 600 К также не наблюдается.

При температуре ниже 400К в системе наблюдается фризинг.